

Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0 - SSD -
verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 -
PCIe 5.0 x2 (NVMe)

256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0

Gruppe	SSDs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MZ-V9S2T0BW
EAN/UPC	8806095575650



Beschreibung

Die Samsung 990 EVO Plus ist ein leistungsstarkes internes Solid State-Laufwerk, das mit einer Kapazität von 2 TB die Speicherleistung erhöht. Ausgestattet mit der Samsung V-NAND TLC-Technologie gewährleistet dieses Laufwerk eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit einer internen Datenrate von 7250 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 6300 MB/s, was einen nahtlosen Betrieb für anspruchsvolle Anwendungen und die Verwaltung großer Dateien ermöglicht. Mit der Unterstützung von PCI Express 4.0- und 5.0-Schnittstellen erfüllt es verschiedene Systemanforderungen und bietet gleichzeitig Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Intelligent TurboWrite Technology und einem Auto Garbage Collection Algorithmus sorgt die Samsung 990 EVO Plus auch bei hoher Arbeitsbelastung für Effizienz und Haltbarkeit. Mit einer Stoß- und Vibrationsfestigkeit von bis zu 1500 g und einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C ist sie sowohl für private als auch für professionelle Umgebungen geeignet. Diese SSD gewährleistet einen schnellen Datenzugriff und bietet eine Hardwareverschlüsselung für verbesserte Sicherheit, was sie zu einer idealen Wahl für Benutzer macht, die die Systemleistung verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0 - SSD - 2 TB - PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
Gewicht	9 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Breite	22.15 mm
Tiefe	80.15 mm
Höhe	2.38 mm
Gewicht	9 g
	Leistung
Interner Datendurchsatz	7250 MBps (lesen)/ 6300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	1350000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	1000000 IOPS
	Zuverlässigkeit
MTBF	1.500.000 Stunden
	Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
	Stromversorgung
Energieverbrauch	4.6 Watt (Lesen) 4.2 Watt (Schreiben) 60 mW (Standby) 5 mW (Sleep-Modus)
	Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen	Samsung Magician Software
	Verschiedenes
Gehäusematerial	Nickelbeschichtung
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 1200 TBW
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	20 g @ 20-2000 Hz

